

	<p>SIRA12BDP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIRA12BDP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 30V</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SIRA12BDP-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 50 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SIRA12BDP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 30V
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	50 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.3 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 38W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIRA12BDP-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1470pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 27A (Ta), 60A (Tc) 5W (Ta), 38W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	27A (Ta), 60A (Tc)

SIRA12BDP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA12BDP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA12BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIRA12BDP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRA12DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 25A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA10BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 30V</p>	 <p>SIRA14DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 58A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA06DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>
 <p>SIRA12DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 25A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA10DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA10DP VISHAY SIRA10DP VISHAY</p>	 <p>SIRA14DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 58A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIRA12BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIRA12BDP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA12BDP-T1-GE3-Datenblätter	SIRA12BDP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIRA12BDP-T1-GE3 Electronic	SIRA12BDP-T1-GE3-Komponenten	SIRA12BDP-T1-GE3-Verteiler	SIRA12BDP-T1-GE3-Bild	SIRA12BDP-T1-GE3
SIRA12BDP-T1-GE3 Preis	SIRA12BDP-T1-GE3 Hersteller	SIRA12BDP-T1-GE3 Bild	SIRA12BDP-T1-GE3 Aktie	SIRA12BDP-T1-GE3-Teil
SIRA12BDP-T1-GE3 Neu	SIRA12BDP-T1-GE3 Original	SIRA12BDP-T1-GE3 garantiert	SIRA12BDP-T1-GE3 RFQ	SIRA12BDP-T1-GE3 Inventar
				SIRA12BDP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited